

КТ617А

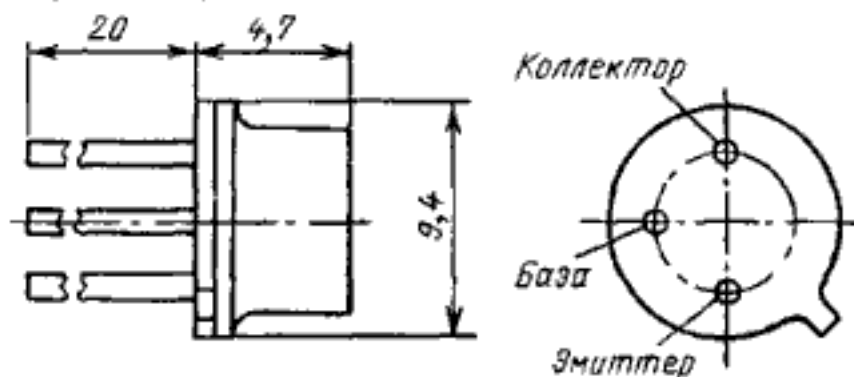
Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный *n-p-n* переключа-
тельный высокочастотный.

Предназначен для работы в переключающих схемах.

Выпускается в металлоглазном корпусе с гибкими выводами.

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 0,84 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 2$ В, $I_Э = 0,4$ А не менее	30
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_К = 150$ мА, $I_Б = 15$ мА не более	0,7 В
Модуль коэффициента передачи тока при $U_{КБ} = 10$ В, $I_Э = 30$ мА, $f = 100$ МГц не менее	1,5
Постоянная времени цепи обратной связи при $f = 5$ МГц, $U_{КБ} = 5$ В, $I_К = 5$ мА не более	120 пс
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ0} = 10$ В не бо- лес	15 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ0} = 0$ не более	50 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{КБ0} = 30$ В не более	15 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ0} = 4$ В не более	15 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} = 10$ кОм	20 В
Постоянное напряжение коллектор-база	30 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Постоянный ток коллектора	400 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_n = 80$ нс, $Q \geq 10$	600 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
при $T = 233 \div 298$ К	0,5 Вт
при $T = 358$ К	0,3 Вт
Тепловое сопротивление переход-окружающая сре- да	215 К/Вт
Температура перехода	423 К
Температура окружающей среды	От 233 до 358 К

Примечание. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора паяльником, нагретым до температуры 533 К, в течение не более 10 с. Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5–3 мм. Запрещается кручение вывода вокруг оси.